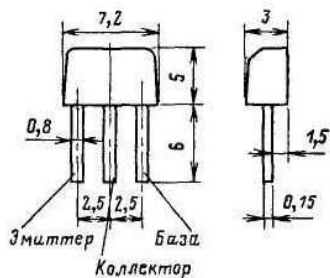


КТ361А, КТ361Б, КТ361В, КТ361Г, КТ361Д, КТ361Е



Транзисторы кремниевые эпитаксиально-плоскостные *p-n-p* усилительные высокочастотные. Предназначены для работы в усилителях высокой частоты. Выпускаются в пластмассовом корпусе с гибкими выводами. Обозначение типа приводится в этикетке. Масса транзистора не более 0,3 г.

Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{КБ} = 10$ В, $I_Э = 1$ мА:

при $T = 298$ К:

КТ361А, КТ361Д	20 – 90
КТ361Б, КТ361Г, КТ361Е	50 – 350
КТ361В	40 – 160

при $T = 373$ К:

КТ361А, КТ361Д	20 – 250
КТ361Б, КТ361Г, КТ361Е	50 – 500
КТ361В	20 – 300

при $T = 213$ К:

КТ361А, КТ361Д	10 – 90
КТ361Б, КТ361Г, КТ361Е	15 – 350
КТ361В	10 – 160

Модуль коэффициента передачи тока при $f = 100$ МГц,

$U_{КБ} = 10$ В, $I_Э = 5$ мА не менее 2,5

Постоянная времени цепи обратной связи при $f = 5$ МГц,

$U_{КБ} = 10$ В, $I_Э = 5$ мА не более:	
КТ361А, КТ361Б, КТ361Г	500 пс
КТ361В, КТ361Е	1000 пс
КТ361Д	250 пс

Емкость коллекторного перехода при $U_{КБ} = 10$ В, $f = 10$ МГц не более

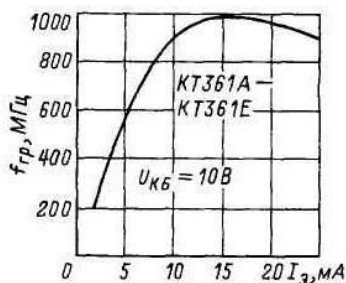
КТ361А, КТ361Б	9 пФ
КТ361В, КТ361Г, КТ361Д, КТ361Е	7 пФ

Обратный ток коллектора при $U_{КБ} = 10$ В не более:

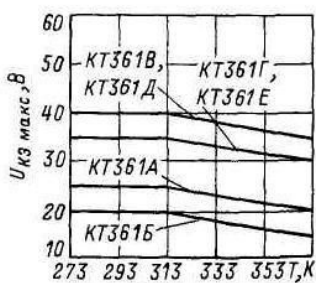
при $T = 298$ К и $T = 213$ К	1 мкА
при $T = 373$ К	25 мкА

Обратный ток коллектор-эмиттер при $R_{БЭ} = 10$ кОм,

$U_{КЭ} = U_{КЭ\text{ макс}}$ не более 1 мкА



Зависимость граничной частоты от тока эмиттера.



Зависимость максимально допустимого напряжения коллектор-эмиттер от температуры.

Предельные эксплуатационные данные

Постоянные напряжения коллектор-база, коллектор-эмиттер при $R_{БЭ} = 10$ кОм:

при $T = 213 \div 308$ К:

КТ361А	25 В
КТ361Б	20 В
КТ361В, КТ361Д	40 В
КТ361Г, КТ361Е	35 В

при $T = 373$ К:

КТ361А	20 В
КТ361Б	15 В
КТ361В, КТ361Д	35 В
КТ361Г, КТ361Е	30 В

Постоянное напряжение база-эмиттер 4 В

Постоянный ток коллектора 50 мА

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:

при $T = 213 \div 308$ К 150 мВт

при $T = 373$ К 30 мВт

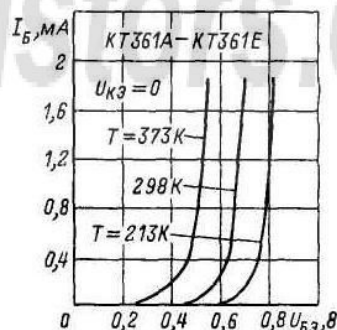
Температура перехода 393 К

Температура окружающей среды От 213 до 373 К

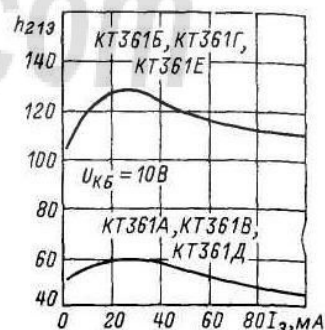
Примечание. Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора, мВт, при $T = 308 \div 373$ К определяется по формуле

$$P_{К\text{ макс}} = (393 - T) / 0,67.$$

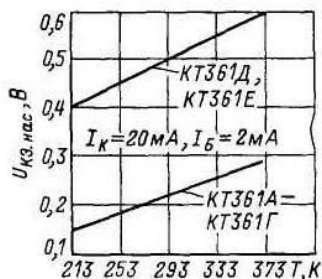
Допускается производить пайку на расстоянии не менее 2 мм от корпуса транзистора. Допускается трехкратный изгиб выводов на расстоянии не менее 2 мм от корпуса при радиусе изгиба 1,5–2 мм. Категорически запрещается кручение выводов вокруг оси.



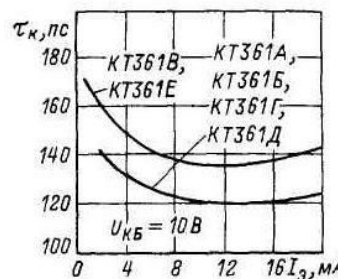
Входные характеристики



Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера.



Зависимость напряжения насыщения коллектор-эмиттер от температуры



Зависимость постоянной времени цепи обратной связи от тока эмиттера